



## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03197484 A

(43) Date of publication of application: 28.08.91

(51) Int. Cl C07F 7/08

(21) Application number: 01339792

(22) Date of filing: 27.12.89 (72) Inventor:

SHIN ETSU CHEM CO LTD (71) Applicant:

> YAMAMOTO YASUSHI MATSUDA TAKASHI

## (54) PRODUCTION OF HYDROGENSILOXANE

#### (57) Abstract

PURPOSE: To industrially and advantageously obtain the subject compound by reacting chlorosilane with 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxane in the presence of water and an acid at a specific temperature.

CONSTITUTION: A compound expressed by formula I or II (R is halogenated hydrocarbon, fluorine-substituted ether, etc.; Me is methyl; (n) is 1-3; (m) is 1 or 2) is made to react with 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxane in the presence of an aqueous solution of an acid composed of water in a molar amount of 1-3 times based on Cl in the chlorosilane and concentrated hydrochloric acid in an amount of 1-3 times based on the water at 230°C (preferably 0-20°C) for 3-6hr to afford the objective compound expressed by formula III or IV.

COPYRIGHT. (C)1991, JPO& Japio

ĮΥ

⑩日本国特許庁(JP) ⑪特許出願公開

## @ 公開特許公報(A) 平3-197484

@Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)8月28日

C 07 F 7/08

Y 8018-4H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 36 頁)

○発明の名称 水素シロキサンの製造方法

②特 順 平1-339792

❷出 願 平1(1989)12月27日

個発 明 者 本 蜟 群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社

@発 明 者 松田 高至

シリコーン電子材料技術研究所内

群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社 シリコーン電子材料技術研究所内

勿出 願 人

信越化学工業株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番1号

②代 理 人 弁理士 岩見谷 周志

1. 発明の名称

水素シロキサンの製造方法

2. 特許請求の範囲

(1)下記一般式、

R. Si (OSiH)

あるいは、

Mes-m Me RSI (OSÍN) "

**前記式中、** 

Rは、それぞれ、パロゲン化炭化水素基、 フッ素置換エーテル基または炭素数 2 以上の **炭化水素基の何れかを示し、これらは互いに** 間一でも異なっていてもよく、

Neは、メチル基を示し、

nは、1万至3の整数を示し、

mは、1または2の整数を示す、

で表される水素シロキサンの製造方法であって、

下配一般式、

Ra-asici.

あるいは、

Mes-n PSICI.

(前記式中、R. He, 及びmは、前述した意味 を表す、)

で表されるクロルシランと、1,1,3,3-テトラメチ ル-1.3-ジシロキサンとを、敵の存在下で30℃以 下の繊皮で反応させることを特徴とする方法。

3. 発明の詳細な影明

(産業上の利用分野)

本発明は、特定の化学構造を有する水素シロキ サンの製造方法に関する。

(世来技術)

下配一般式、

Мe Pr. Si (OSIA) (1) Йe

あるいは、

前記式中、

Rは、それぞれ、ハロゲン化炭化水素基、 フッ素置換エーテル基または炭素数2以上の 變化水素基の何れかを示し、これらは互いに 同一でも異なっていてもよく、

Meは、メチル基を示し、

nは、1万至3の整数を示し、

mは、1または2の整数を示す、

で表される水紫シロキサンの製造方法として、シ ロキサンの酸平衡による方法及びクロロシランの 共加水分解による方法が、従来公知である。

例えば数平衡によるものとして、下記反応式、

3

(=) R.Okawara, M. Sakiyama, Bull. Chem. Japan, 29.236(1956).

(発明が解決しようとする問題点)

然しながら、前記反応式 (a) の平衡反応を利 用した製造方法では、原料のジシロキサンが残存 し、収率がかなり低く、また前記反応式(b)の 平衡反応を利用した製造方法では、敷りが2以上 のポリシロキサンが劇生し、目的とするトリシロ キサンの収率は、必ずしも満足しうるものではな W.

更に、前記文獻に記載されたクロロシランの共 加水分解による製造方法は、有機基Rの種類によ っては、Ra-aSiCla が複数機能合した水素シロキ サンが剛生するという問題がある。

従って本発明の目的は、副生物の形成が有効に 御朝され、極めて高い収率で前紀一級式(1)あ るいは(1)で表される水素シロキサンを製造す ることが可能な方法を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明の製造方法は、下記一般式、

で表されるシロキサン化合物の平衡反応により、 前記一般式(I)のm = iの水素シロキサンを製 進する方法が知られており、また前記一般式(『) のm=2の水素シロキサンを、下紀反応式、

(式中、aは3または4、

bは1以上の整数である)

で表されるシロキサン化合物の平衡反応により製 造する方法が知られている。

またクロロシランの共加水分解による方法とし ては、Ra-aSiCla 及び BSi(Me)zCl で裏されるク ロロシランの混合物を、共加水分解する方法が下 記の文献に記載されている。

- (イ) 米国特許第2,877,255 号明報書。
- (ロ)米国特許第2,877,256 号明都書。
- (ハ) R.Okawara,工業化学雑誌、<u>60</u>,1398(1957).

(前記式中、R. He, 及びmは、前逃した意味 在裏寸、)

で表されるクロルシランと、1,1,3,3-テトラメチ ル-1.3-ジシロキサンとを、酸の存在下で30℃以 下の線度で反応させることにより、前記一般式 (i) あるいは(B)で妻される水素シロキサン を製造するものである。

**声ち、上記のような手段を採用することにより、** クロルシランの加水分解により生成するシラノー ルと、1,1,3,3-テトラメチル-1,3-ジシロキサン との反応が極めて遵やかに進行して目的とする水 煮シロキサンが得られ、この結果として、シラノ 一ル間での縮合反応や生収した水素シロキサンの 平衡反応が有効に誤避され、該水素シロキサンが 極めて高い収率で得られるのである。

原料化合物

特勝平 3-197484(3)

本発明においては、上述した漏り、出発順料化合 動としてクロロシラン及び1.1.3.3.チトラメチル -1.3-ジシロキサンを使用する。

このクロロシランは、前紀一般式(質) あるいは (IV)、即ち、

あるいは、

で表されるものである。

上記一般式(目)、(N)において、nは1乃至3の整数であり、mは1または2の整数である。更に基尺は、それぞれ、ハロゲン化炭化水業基、フッ素置換エーテル基または提来数2以上の炭化水業基の何れかを示し、これらは互いに関一でも異なっていてもよく、具体的には、次のものを例示することが出来る。

炭素数2以上の炭化水素基として、エチル、プロピル、プチル、ヘキシル、ヘブチル、オクチル、 ノニル、デシル、ウンデシル、ドデシル、トリデ シルチトラデシル、ペンタデシル等の脂肪抜炭化水素基;シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロペナチル、シクロドデシル等の脂環式炭化水素基;フェニル、ナフチル、o-メチルフェニル、m-メチルフェニル、2.3-ジメチルフェニル、3.4-ジメチルフェニル、2.4-ジメチルフェニル、ベンジル、1-フェニルエチル、2-フェニルエチル等の芳香族果炭化水素基等。ハロゲン化炭化水素基として、クロロメチル基、2-クロロエチル基、3-クロロブロビル基及び一般

Cafessi Cheche-

(式中、 a は1,2,3,4,6,8 の何れかの整数) で衰される基等。

フッ素複換エーテル基として、一酸式、

F(CFCFe0) + CF(CHeOCH) + GRCHz-CF CF CF B'

(式中、xは1乃至3の整数、yは0または1 の整数、g'は水素原子またはメチル基)

7

で表されるフッ素置換ポリエーテル基等。

本発明において、上述したクロロシランと1.1. 3.3-テトラメチル-1.3-ジシロキサンとは、彼クロロシラン中の塩素駅子に対して、彼ジシロキサン中の単位  ${\rm HSI}\,({\rm He})_{\,2}\,0_{\,2/2}\,$ が、 $1\sim5$  モル格、好ましくは1.2~1.5 モル格の割合で使用されるのが打造である。

### 反应

クロロシランと1,1,3,3-テトラメチル-1,8-ジ シロキサンとの反応は、酸の存在下で行われる。

この酸としては、糖々の鉱酸の水溶液が用いられるが、特に塩酸が好適である。用いる酸の優は、クロロシランの加水分解により生成したシラノールと1,1,3,3-チトラメチル-1,3-ジシロキサンとの総合反応の触媒として有効に作用する限りにおいて特に制限はないが、一般的には、クロロシラン中の塩素原子に対して1~3倍そルの水と、この水に対して1~3重量倍の糖塩酸とからなる量の酸水溶液を用いるのがよい。

またこの反応は、30℃以下、好ましくは0万至

20℃の温度で行うことが必要である。反応温度が 20℃を構えると、クロロシランの加水分解により 生成したシラノール両士が輸合してポリシロキサ ンを馴生したり、あるいは生成した水素シロキサ ンの平衡反応を生じる等の制反応が発生し、収率 が係下する。

反応は、1.1.3.3-チトラメチル-1.3-ジシロキサンと酸水溶液との混合物に、前述したクロルシランを摘下することによりおこなわれる。補下液度は、クロルシラン同士の総合反応が抑えるもの程度に十分低いものであれば特に制限されるものではなく、原料のクロルシランの置換薬Rの種類に応じて適宜調節すればよいが、生産性を考慮すれば、過常3~6時間の範囲とすることが好過である。クロルシランを一度に前記混合核に加えたりすると、クロロシランの加水分解により生成したシラノール同士の総合が多く発生し、目的とする水素シロキサンの収率が低下する場合がある。

また本発明においては、上記反応の実施に際して、塩化水素や水素シロキサン等に対して非反応

特別平 3-197484(4)

性の非水搾性有機物紙を使用することも可能であるが、1,1,3,3-テトラメチル-1,3-ジシロキサン並びに生成する水素シロキサンが搾剤としての投制を果たすため、特にこのような有機溶媒を用いる必要はない。むしろ有機溶媒の使用は、反応後の廃溶剤の処理、黄細節的等の面で不利となる場合がある。

また従来の方法では、加水分解の速度を増大させるために、メタノール、エタノール等の水溶性 有機溶剤を用いる方法が採用されているが、本発 明方法では、その反応速度が十分に速く、この様 な水熔性有機溶剤を使用する必要はない。 水素シロキサン

反応終了後は、常法の精製処理を行うことにより、前記一般式 (1) あるいは (1) 、野ち、

1 1

保った。 要拌を十分行いながら、メチルエチルジ クロロシラン114gを4時間かけて摘下した。 摘下 中、 密素を系内に抜し、生成するIICI を系外に除 くとともに、塩化水素の素発熱を利用して、反応 系を10で以下に保った。

清下終了後、反応混合物が20℃以下の温度に保 たれるように、200ml の水を加えた。この有機層 について、水洗 2 回、MaRCO<sub>2</sub>水(5%)での洗浄を 2 回、更に水洗 5 短を繰り返した後、Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>で乾燥 を行ない、減圧素智を行った。

65~66℃/60mmNgの留分として、1.1.3.5.5-ペ ンタメチル-5-エチル-1.3.5-トリシロキサン

(式中、Meはメチル基、Piはエチル基を示す、 以下間じ。)

が、7.1%の収率で得られた。また得られた水素シロキサンの赤外吸収スペクトルを第 1 図に示した。 尚、ガスクロマトグラフィー(SE-30,10% 3mカ (式中、R,n,m は、前述した意味を有する)で表される水素シロキサンが、高い収率で得られる。即ち、一般式(量)のクロルシランを用いると、前配(1)式の水素シランが得られ、一般式(Ⅳ)のクロルシランを用いると、前配( ■ )式の水素シランが得られる。

この水素シロキサンのうち、 n = { のものは、ケイ素ー水素結合の反応性を活用して、樹脂のと変 割として有効に使用され、また有機基尺としてフッ素原子を含むものを有しているものは、フッ 素の有する優れた界面特性、耐熱性、耐薬品性等を相手の基質に付与することができる。さらに、n = 2 または3 のものは、ケイ素ー水素結合の反応性を利用して、樹脂、ゴム等の架構剤、加碳促進剤等の用途に適用される。

#### (実施例)

**宝施**到\_1

1.1.3.3-チトラメチル-1.3-ジシロキサン
134g(1.0モル)、水30g及び機塩酸80gを、4つ
ロフラスコに仕込み、氷水で冷却し、5~10℃に

1 2

ラム) の測定により、1.1.3,5.7.7-ヘキサメチル -3,5-ジエチル-1,3,5,7- テトラシロキサン、

> Me Et Et Me | | | | | NS10-S1-0S1-0S1N | | | | He Me Me Me

が7%生成していることが認められたが、それ以上の長額シロキサンの生成は認められなかった。 実施例2~18

実施例 1 に従って、一般式 (N) で表される種々のクロルシランと1,1,3,3-テトラメチル-1,3-ジシロキサンとを仮応させ、水素シロキサンを得た(実施例 2~12)。また一般式 (目) で表される種々のクロルシランを使用して、同様に水素シロキサンを得た(実施例13~18)。

得られた水素シロキサンの収率、構造等を第1 表、第2表に示すとともに、その赤外吸収スペクトルを第2図~第18図に示す。 

実施例地	R	Мв	m	収率 (1)	排点(T/mallg)
2	i - Bu	Ne., -	2	7.6	82~ 84 / 30
3	Ph	He , -	2	8 4	76~ 78 / 3
4	CF.CH.CH.	Иа, —	2	8 8	79~ B0 / 57
5	C4P4CH±CH±	'Ne . He	1	9 0	65 / 20
6	C4F+CH+CH+	Ne , -	2	В ?	65~ 66 / 5
7	CaF, zGB, CH,	Ne , Ne	1	8 8	81~ 82 / 11
8	C.F. CH.CH.	Na , Ne	1	8 7	76~ 78 / 3
9	CaFigCNaCNa	Же, —	2	9 3	92~ 94 / 4
1 0	CsF+OCFGH2O(CHs)s i CFs	He . Ne	1	9 2	73~ 75 / 5
1 1	F(CFCF±C) #CFCH±O(CH±) # [	Me , Xe	1	9 0	100~103 / 5
1 2	F(CFCF±0)sCFCH±0(CH±)s  I CFs CFs	No . Ne	1	8 9	112~115 / 3

\*Bnはブチル基を示し、Pbはフェニル基を示す。

15

祭 2 表

He l R4-mSi(OSiH)m の合成 I He

実施例 No.	. R	n	収率 (%)	排点 (℃/mmHg)
1 3	n-Caffee , ——	3	8 5	81~ 83 / 3
1 4	Ph , Ph	2	8 7	121~123 /2.4×10-4
1 5	Рь —	3	8 7	90~ 91 / 2
1 6	CsF, TCHECKE	3	8 5	103~104 / 3.5
1 7	Me C <sub>3</sub> F <sub>1</sub> OCPCH-CN <sub>x</sub> , ———————————————————————————————————	3	9 1	102~104 / 15
1 8	F(CFCF:0);CFCH:0(CH:); ; ; CF; CF;	3	8 9	101 / 4

\*Phはフェニル基を示す。

特別平 3-197484(6)

## 比較到上

ジメチルクロロシラン(0.8モル) 老、1,1,3,3-テトラメチル・1,3-ジシロキサン(1.0モル)、水 (30g)及び譲塩験 (80g) の混合物中に被下し て、5~10℃で加水分解を行った。

得られた水素シロキサンは、次の通りである。

1	No (510) =	Me i SiN !
---	---------------	---------------------

n	収率(%)
1	2 6
2	2 7
3	7

この結果から明かな過り、ジメチルジクロロシ ランが縮合したタイプ (n ≥ 2) の生戦勢が、相 当量器生することが確認された。

# (発明の効果)

本発明の製造方法によれば、出発顕料であるク

ロロシランが譲合したポリシロキサンの副生が殆 どなく、貰い収率で、目的とする水素シロキサン が得られる。

また、現在工業的には、1,1,3,3-テトラメチル -1.3-ジシロキサンを脈料としてジメチルクロロ シランが製造されているから、1,1,3,3-テトラメ チル-1.3-ジシロキサンを用いる本発明は、ジメ チルクロロシランを使用する従来法に比べて、エ 果的に振めて有利である。

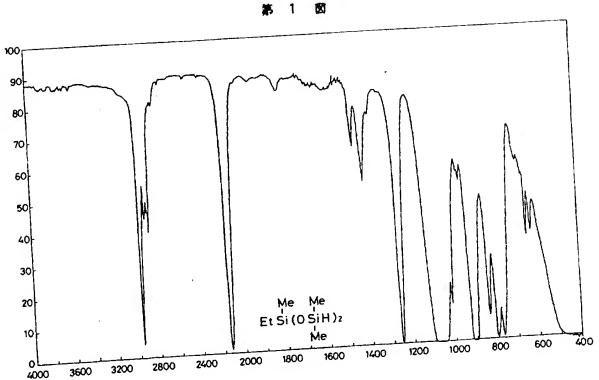
# 4、 図面の簡単な説明

第1図~第18図は、実施例1~18で得られた水 楽シロキサンの赤外線吸収スペクトルである。

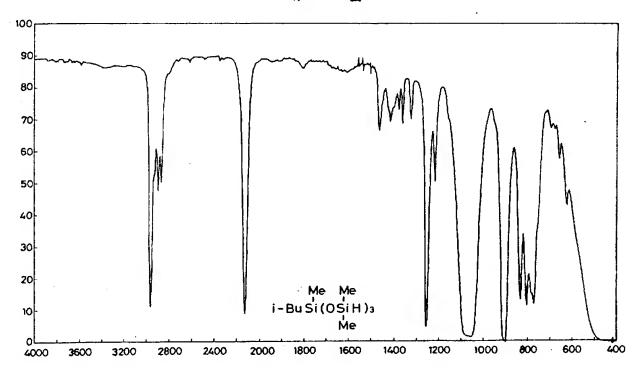
代理人 弁理士 岩見谷 間志

1 7

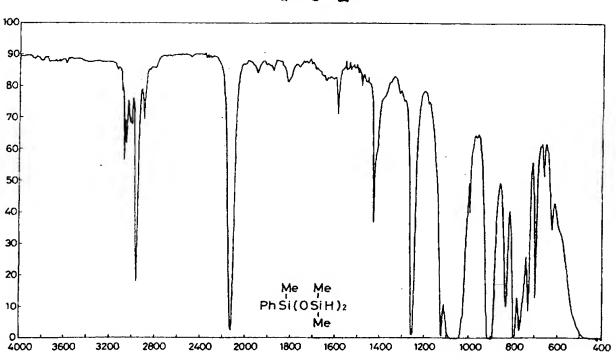
1 8



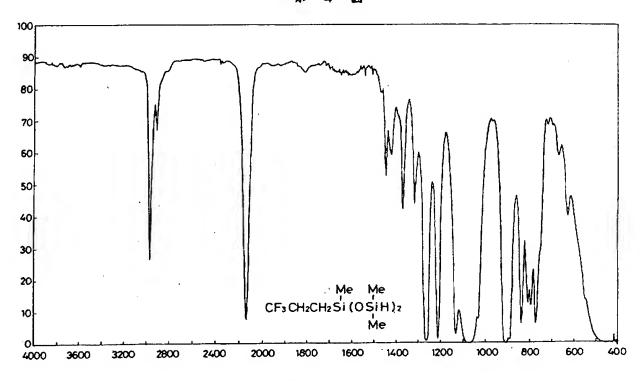
第 2 図



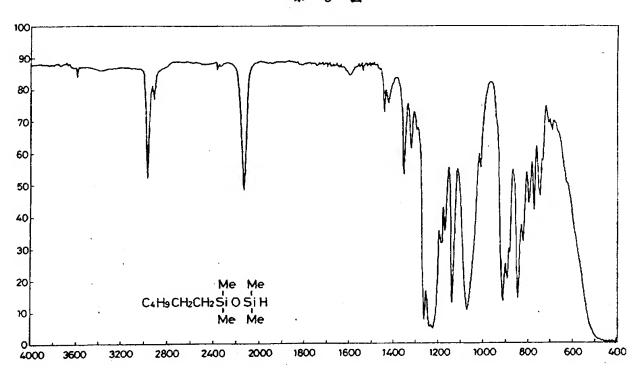
第 3 図



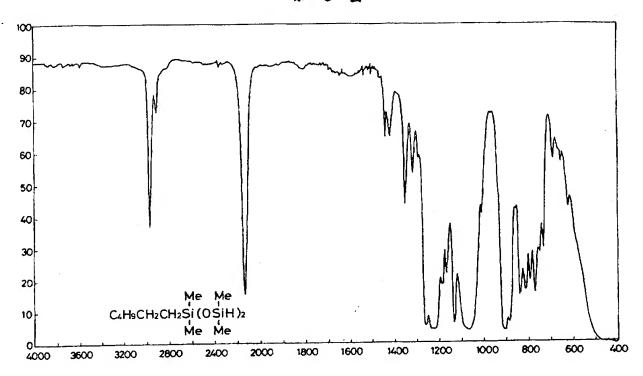
第 4 図



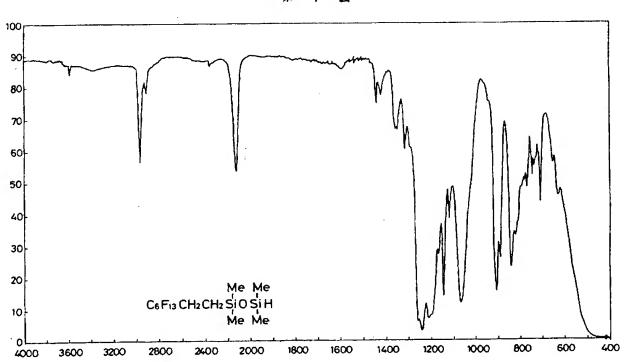
第 5 図



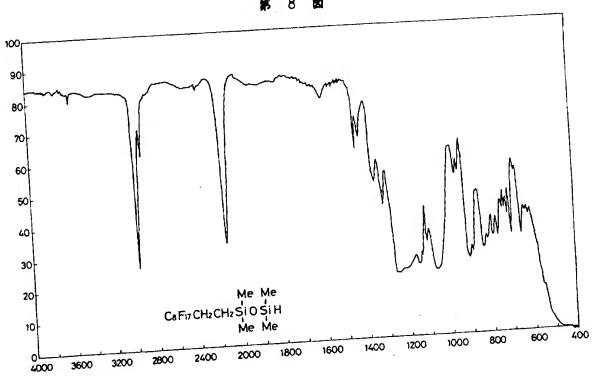
第 6 図



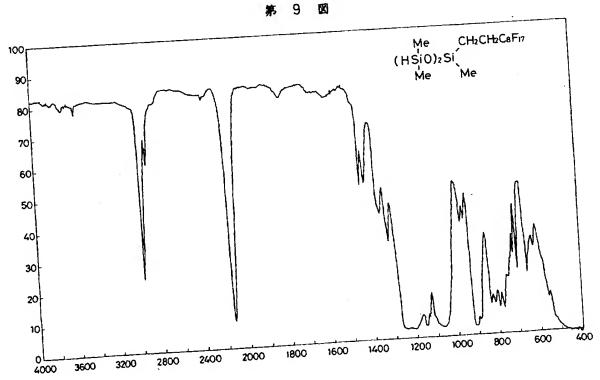
第 7 図



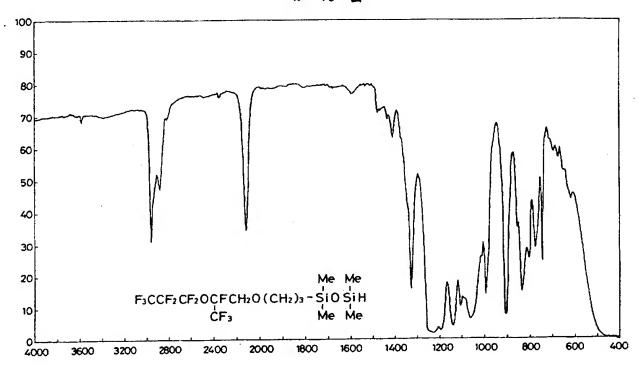




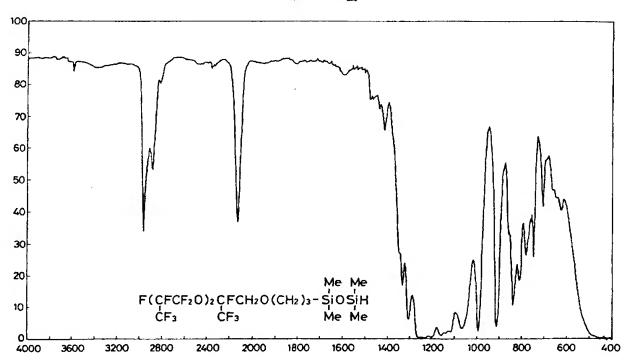
## K



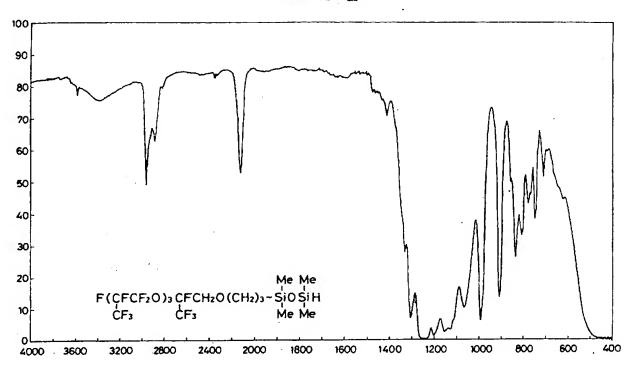
第 10 图



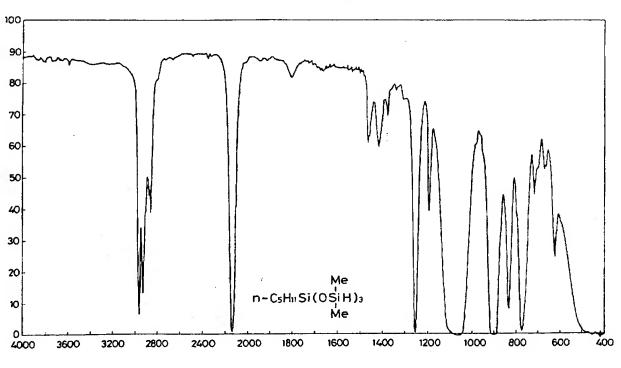
第 11 図



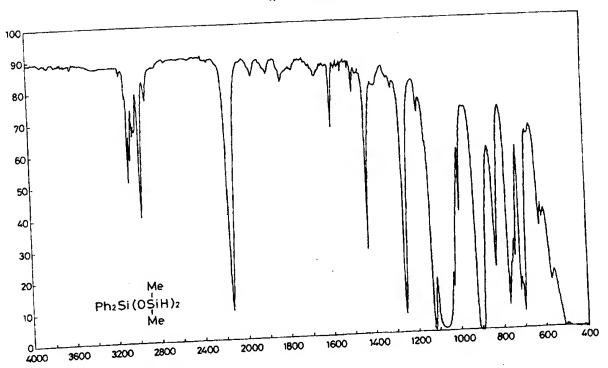
第 12 図



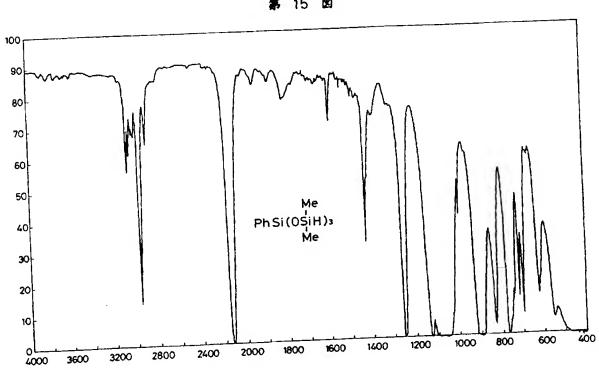
第 13 図

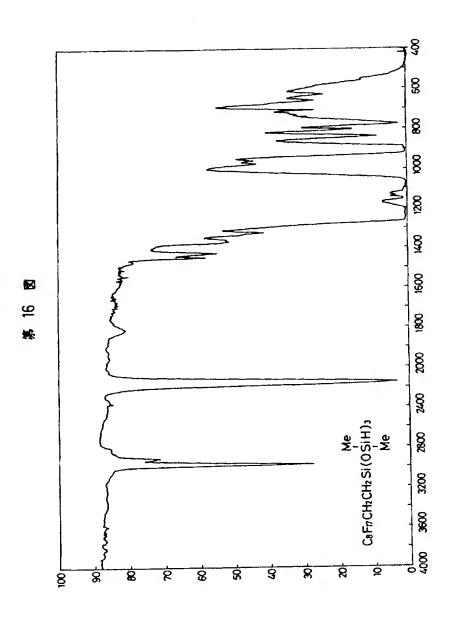


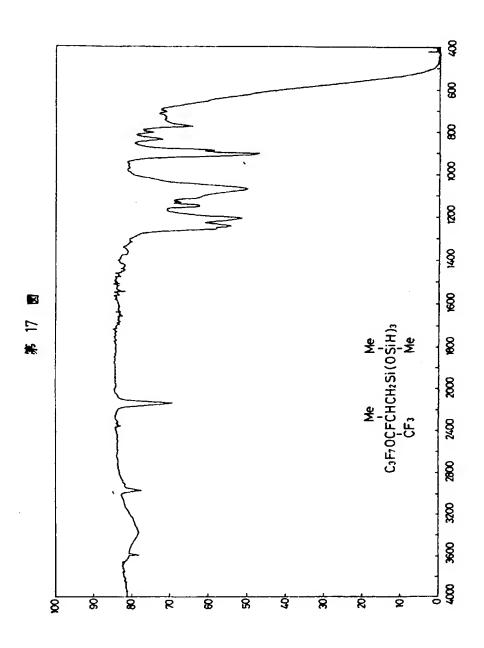
14 図

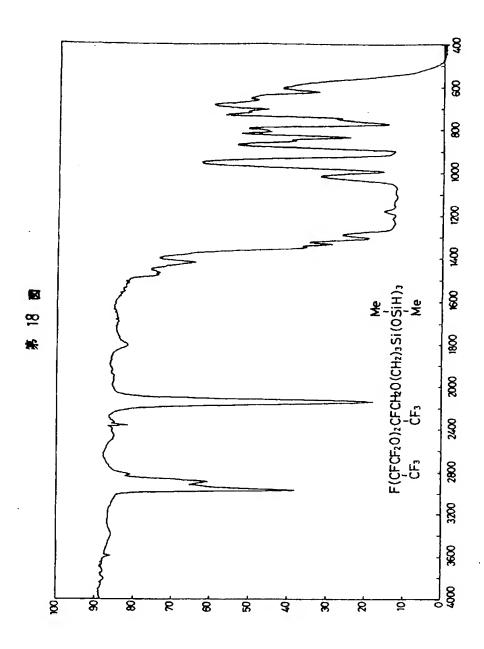


15 図









#### 手統補正書(自発)

平成3年1月22日

#### 特許庁長官 殴

懂

1 事件の要示

平成1年特許順第339792号

2. 発明の名称

水素シロキサンの製造方法

3. 補正をする者

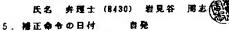
事件との関係 特許出職人

住所 京京都千代田区大手町二丁目6番1号

名称 (206) 信能化学工業株式会社

4. 代理人

〒101 東京都千代田区神田神保町 1-2-3 住所 水野ビル6F 音(03)3219-6741



6. 補正により増加する請求項の飲

7、補正の対象

明細書の「特許請求の範囲」及び「発明の詳細 な説明」の概並びに函面



方式

(4) 下記(c)~(h)の

「平衡反応」との記載を

『平衡化反応』と補正する。

- (c) 明細書の第4頁第1行目
- (d) 明報書の第4頁第9行目
- (a) 明細書の第5頁第4行目
- (f) 明細書の第5頁第7行目
- (ま) 明報書の第6頁第17行目
- (A) 明顯書の第18頁第5行目
- (5) 下紀(1)~(1)の

「酸の存在下で」との記載を

『水と皺の存在下で』と補正する。

- (i) 明報書の第6頁第7行目
- (j) 明報書の第9頁第10行目
- (6) 下記(k)~(1)の

「生成」との記載を

「剛生」と補正する。

- (k) 明知者の第14頁第4行目
- (1) 明朝書の第14頁第5行目
- (7) 明報書第15頁末行の

8. 補正の内容

- [1] 明智書の「特許請求の範囲」の棚
- (1) 明報書の特許兼求の範囲を別紙のとおりに補 正する。
- [正] 明報書の「発明の詳細な説明」の概
- (1) 明報書第3頁第11行の

「酸平衡による方法」との記載を

『敵を用いる平衡化反応による方法』と補正す

(2) 明報書第3頁第13行の

「酸平衡によるものとして、」との記載を 『酸による平衡化によるものとして、』と推正 T&.

(3) 下記(a)~(b)の

「酸性媒 との記載を

と補正する。

- (a) 明報書の第3頁末行
- (b) 明福書の第4頁第6行目

2

「おは」との記載を 『おは』と補正する。

(8) 明報書第16頁第2表中、実施例No.13 のRの 概における、

「n-Callin」との記載を

『w-Cslin』と補正する。

(9) 明編書第16頁第2要中、実施例No.16のRの 棚における、

「CsfioCNiCNi」との記載を

『CaFinCHiCHis』と袖正する。

- (服) 関節
- (1) 図面を別紙のとおりに補正する。

(別紙)

特許請求の範囲(補正後)

1(1) 下記一般式、

あるいは、

前配式中、

Rは、それぞれ、ハロゲン化炭化水素基、フッ素置換エーテル基または炭素数 2 以上の 炭化水素基の何れかを示し、これらは互いに 関一でも異なっていてもよく、

Heは、メチル基を示し、

nは、1乃至3の整数を示し、

mは、1または2の整数を示す、

で表される水素シロキサンの製造方法であって、

下配一般式、

Ra. . SICI.

あるいは、

Nes-a I RSICI.

(前記式中、R, He, 及びmは、前述した意味

を表す、)

で表されるクロルシランと、1.1.3.3.チトラメチル-1.3.ジシロキサンとを、水と酸の存在下で30 で以下の温度で反応させることを特徴とする方法。』

-

